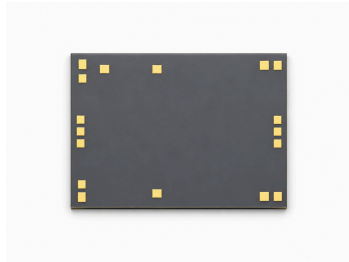


13000–15000 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

脉冲: PSAT: 42 dBm (典型值); 功率增益: 21 dB (典型值); PAE: 35 % (最小值) / 37 % (典型值). 裸片尺寸: 2.8 × 2 × 0.1 mm.



RF 特性 · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; 脉冲

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	f	13000	-	15000	13000–15000	MHz
饱和输出功率	Psat	-	42	-	-	dBm
功率增益	Gp	-	21	-	-	dB
功率增益平坦度	ΔGp	-	±0.35	-	-	dB
功率附加效率	PAE	35	37	-	-	%
输入驻波比	VSWR(in)	-	1.8	-	-	-

直流偏置与电流 · TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏极电压	Vd	24	28	32	V
栅极电压	Vg	-5	-3.05	-2.6	V
静态漏极电流	Id	-	0.11	-	A
动态漏极电流	Idd	-	1.7	-	A
动态栅极电流	Igg	-	0.5	-	mA

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	Vd	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	Vg	-5	-	-	V
最大输入功率	Pin	-	-	24	dBm
储存温度	TSTG	-65	-	150	°C
最高沟道温度	Top	-	-	225	°C

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	$2.8 \times 2 \times 0.1$	mm

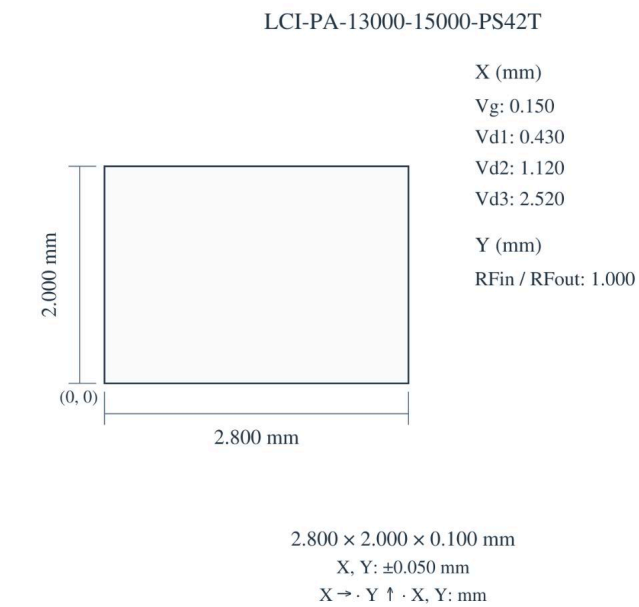
裸片集成与偏置时序

内置隔直电容: RFin / RFout. 直流对地通路: RFin → GND. 独立表征条件: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW; Pin = 21 dBm. 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。建议采用双边供电。

机械参考图适用范围

依据原资料整理的外形及明确标注坐标参考图，单位 mm；不作为完整制造或键合图。

机械外形尺寸图



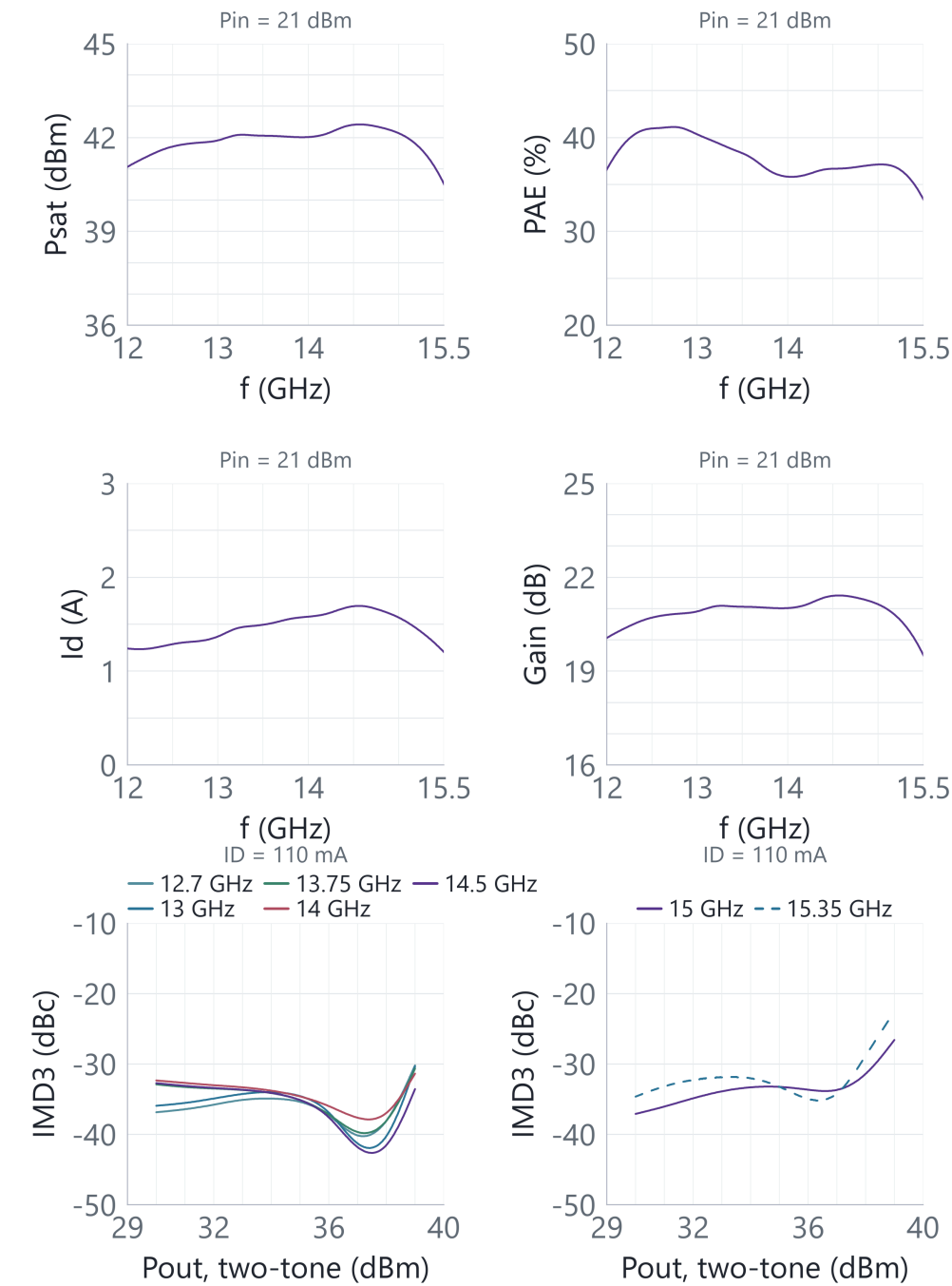
所有尺寸单位为 mm [in]。

性能曲线

以下图表来自原规格书，请结合每张图标明的工作条件阅读。

饱和输出功率、功率附加效率、动态漏极电流、功率增益、IMD3。

原页标注：Vd=+28V; Vg=-3.05V。依照源图曲线重新绘制，图中读数为近似值。Psat/PAE/Id/Gain: Pin = 21 dBm. IMD3: Id = 110 mA.



来源

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。